

## ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УРОВНЕЙ В ТЕТРАГОНАЛЬНОМ ПАРАМАГНЕТИКЕ $\text{YbPO}_4$ В СВЕРХСИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ ДО 400 Тл

З.А.Казей<sup>1)</sup>, Н.П.Колмакова\*, Р.З.Левитин, В.В.Платонов<sup>+</sup>,  
А.А.Сидоренко\*, О.М.Таценко<sup>†</sup>

Физический факультет МГУ  
119899 Москва, Россия

\*Технический университет  
241035 Брянск, Россия

<sup>†</sup>Российский федеральный ядерный центр  
607190 Саров, Нижегородская обл., Россия

Поступила в редакцию 7 апреля 1997 г.

Экспериментально и теоретически исследован эффект пересечения энергетических уровней иона  $\text{Yb}^{3+}$  в парамагнитном  $\text{YbPO}_4$  в сверхсильном магнитном поле до 400 Тл, полученным взрывным методом. Обнаружен широкий максимум дифференциальной восприимчивости  $dM/dH$  в поле  $H_c \approx 280$  Тл, обусловленный пересечением энергетических уровней магнитных ионов в поле. В предположении адабатичности намагничивания в импульсных полях рассчитан магнитокалорический эффект, который имеет немонотонную зависимость от поля и сопровождается значительным охлаждением кристалла вблизи  $H_c$ .

PACS: 71.70.-d, 75.30.Ct, 75.30.Sg

Пересечение энергетических уровней магнитных ионов в поле (кроссовер) и связанный с ним скачок намагниченности были предсказаны теоретически Купером для соединения  $\text{TmSb}$  [1] и наблюдались экспериментально в разных редкоземельных (РЗ) соединениях (см., например, [2]) как в парамагнитном, так и в упорядоченном состояниях. Этот эффект имеет место в тех случаях, когда энергия нижнего уровня основного мультиплета РЗ иона, расщепленного кристаллическим полем, зависит от магнитного поля значительно слабее, чем энергия одного из возбужденных. Поэтому в достаточно сильных полях эти уровни сначала сближаются, а затем меняются местами. Поскольку при этом основным становится более "магнитный" уровень, кроссовер сопровождается скачкообразным увеличением намагниченности  $M$  и максимумом дифференциальной восприимчивости  $dM/dH$ .

Можно ожидать, что в РЗ цирконах  $\text{RXO}_4$  ( $R$  – редкоземельный ион, X=As, P, V) эффекты пересечения уровней будут довольно многочисленными, поскольку достаточно низкая тетрагональная симметрия циркона (пространственная группа  $D_{4h}^{19} = I4_1/amd$ ) обуславливает богатый слабо вырожденный спектр РЗ иона и значительную магнитную анизотропию вдоль и перпендикулярно тетрагональной оси в парамагнитном состоянии. При этом из-за отсутствия неэквивалентных позиций для РЗ иона в структуре циркона эти эффекты должны отчетливо проявляться даже на макроскопических характеристиках, таких, как намагниченность. К настоящему времени из всей серии РЗ цирконов явление кроссовера в сравнительно слабых магнитных полях ( $\sim 10$  Тл) исследовано только в парамагнитном  $\text{HoVO}_4$  [3–5]. Значительный прогресс в

<sup>1)</sup>e-mail: kasei@plm2.phys.msu.su

технике получения сильных и сверхсильных магнитных полей делает эффекты пересечения уровней в настоящее время доступными для экспериментального исследования. В данной работе экспериментально и теоретически исследован эффект пересечения уровней в парамагнитном  $\text{YbPO}_4$ .

Измерения были выполнены при 4.2 К индукционным методом в импульсных магнитных полях до 400 Тл, полученных взрывным методом [6], на монокристалле  $\text{YbPO}_4$ . Время возрастания поля в импульсе составляло 15 мкс. Данные измерения являются однократными и измерительные катушки и образцы разрушаются после каждого импульса, при этом не удается полностью скомпенсировать сигнал от магнитного поля. Таким образом, сигнал, наводимый в измерительных катушках, может быть записан в виде

$$V_1(H) \sim \frac{dM}{dt} + K \frac{dH}{dt}, \quad (1)$$

где первый член соответствует сигналу от образца, а второй – сигналу раскомпенсации катушек. В течение импульса поля с интервалом 0.002 мкс проводилась запись сигналов  $V_1$  и  $V_2 \sim dH/dt$  с измерительной и "полевой" катушек (около 8000 точек). Эти данные позволяют рассчитать кривые  $V_1(H)/V_2(H)$  (которые в предположении слабой зависимости сигнала раскомпенсации от величины поля с точностью до постоянной величины  $K$  пропорциональны дифференциальной восприимчивости образца  $dM/dH = (dM/dt)/(dH/dt)$ ), а также провести усреднение сигнала по времени для уменьшения высокочастотных флуктуаций фона.

На рис.1 приведены экспериментальная и теоретические зависимости  $dM/dH$  монокристалла  $\text{YbPO}_4$  для магнитного поля вдоль тетрагональной оси [001]. Широкий максимум восприимчивости при  $H_c \approx 280$  Тл связан с пересечением энергетических уровней иона  $\text{Yb}^{3+}$ . Значительная ширина максимума обусловлена, по-видимому, изменением температуры образца вследствие магнитокалорического эффекта при намагничивании в импульсном поле. Поскольку времена спин-решеточной релаксации в РЗ ионных соединениях весьма малы ( $\sim 10^{-9}$  с, см., например, [7]) по сравнению с длительностью импульса поля, электронная подсистема и решетка при измерении находятся в равновесии, а процесс намагничивания близок к адиабатическому. На наш взгляд, теплобмен образца с окружающей средой не существен уже в импульсных полях с длительностью импульса  $\sim 10$  мс, о чем свидетельствует совпадение кривых намагничивания при возрастании и уменьшении поля.

Для расчета эффекта Зеемана и магнитных характеристик использовался гамильтониан, включающий гамильтониан кристаллического поля, записанный через неприводимые тензорные операторы  $C_q^k$ , и зеемановский член:

$$H = B_0^2 C_0^2 + B_0^4 C_0^4 + B_0^6 C_0^6 + B_4^4 (C_4^4 + C_{-4}^4) + B_4^6 (C_4^6 + C_{-4}^6) + g_J \mu_B H \cdot J. \quad (2)$$

Здесь  $B_q^k$  – параметры кристаллического поля,  $g_J$  – фактор Ланде. Параметры кристаллического поля для иона  $\text{Yb}^{3+}$  в матрице фосфата известны только для легированных соединений  $\text{Yb:LuPO}_4$  и  $\text{Yb:YPO}_4$  [8] (они различаются сильно по параметру  $B_0^2$ ) и могут, вообще говоря, заметно отличаться от значений для концентрированного соединения  $\text{YbPO}_4$ . Поле кроссовера  $H_c$  определяется спектром и волновыми функциями основного мультиплета  $2F_{7/2}$  иона  $\text{Yb}^{3+}$ , формируемыми кристаллическим полем. Наши расчеты с параметрами кристаллического поля для  $\text{Yb:YPO}_4$  и  $\text{Yb:LiPO}_4$  дают для  $H_c$

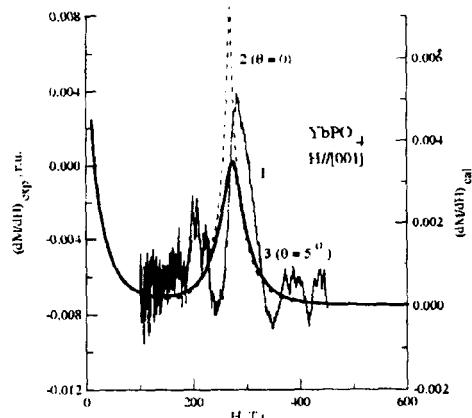


Рис.1. Экспериментальная (1) и рассчитанные (2, 3) зависимости дифференциальной восприимчивости  $dM/dH$  для  $\text{YbPO}_4$  для ориентации магнитного поля вблизи тетрагональной оси [001] ( $\theta$  – угол ориентации)

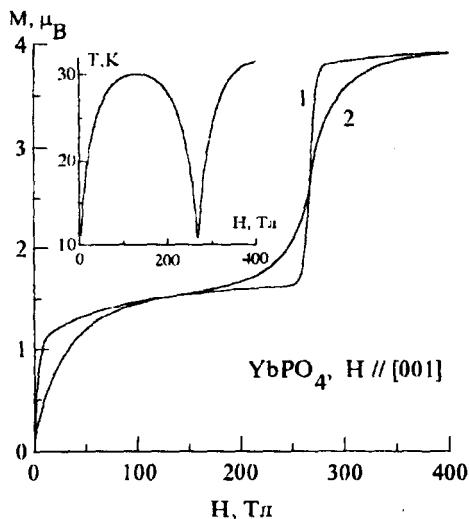


Рис.2. Изотермическая (1) и адабатическая (2) кривые намагничивания  $M(H)$   $\text{YbPO}_4$  для начальной температуры  $T_0 = 4.2\text{K}$  и изменение температуры образца  $T(H)$ , обусловленное магнитокалорическим эффектом при адабатическом намагничивании

значения 210 Тл и 180 Тл, соответственно. Численный анализ показывает, что величина поля кроссовера наиболее чувствительна к параметру  $B_0^2$ . Решение оптимизационной задачи для  $\text{YbPO}_4$  с учетом всей имеющейся экспериментальной информации (спектроскопия и ЭПР [8,9], а также наши магнитные измерения) позволило получить параметры кристаллического поля, которые укладываются в границы их изменения по ряду РЗ фосфатов и дают теоретическое значение  $H_c = 270\text{ Тл}$ . В пределах точности измерения поля  $\pm 10\%$  и возможной разориентации образца  $\leq 3^\circ$  это значение хорошо совпадает с экспериментальным.

Интересной особенностью кроссовера в  $\text{YbPO}_4$  является то, что основной уровень ( $g_z^{gr} \sim 2$ ) пересекается нижним уровнем первого возбужденного дублета, для которого  $z$ -компоненты  $g$ -тензора в отсутствие магнитного поля существенно меньше ( $g_z^{exc} < 0.1$ ). Однако в поле происходит сильное примешивание к нижнему уровню первого возбужденного дублета состояния  $|+7/2\rangle$  от третьего возбужденного дублета, принадлежащего к тому же представлению, и сильное возрастание его  $g_z$ . Для основного дублета  $g_z$  в поле меняется не так сильно из-за слабого примешивания к нему от второго возбужденного дублета. Отметим, что для ориентации поля строго вдоль тетрагональной оси смешивание волновых функций основного и первого возбужденного дублетов отсутствует и поэтому должно наблюдаться "истинное" пересечение уровней. Разориентация поля уже в 3–5 градусов приводит к появлению в волновой функции основного уровня компоненты  $|\pm 7/2\rangle$  и к взаимодействию между основным и первым возбужденным уровнями, что обуславливает небольшую щель (расталкивание уровней) в спектре в районе полей кроссовера. Ре-

зультатом этого является уширение максимума  $dM/dH$  и возрастание поля кроссовера.

При расчете магнитных характеристик для каждого значения поля от 0 до 400 Тл с шагом  $\Delta H = 0.01$  Тл проводилась численная диагонализация гамильтониана (2) для определения спектра и волновых функций иона  $\text{Yb}^{3+}$  и рассчитывался "элементарный" магнитокалорический эффект  $\Delta T$  при изменении поля от  $H$  до  $H + \Delta H$ :

$$\Delta T = -(\partial M / \partial T)_H T \Delta H / C_H. \quad (3)$$

В этой формуле полная теплоемкость кристалла  $C_H$  включает теплоемкость решетки  $C_{lat} \sim (T/T_D)^3$  (дебаевская температура для решетки фосфата  $T_D = 275$  К [10]) и магнитную теплоемкость  $C_{mag}$ , рассчитываемую при каждом значении поля и температуры, исходя из спектра РЗ иона. Эти данные позволили рассчитать изотермическую и адиабатическую намагниченности  $\text{YbPO}_4$  и температуру образца как функцию магнитного поля (рис.2). Последняя имеет немонотонный характер, то есть сначала образец нагревается примерно на 25 К, а затем в районе полей кроссовера охлаждается примерно на 20 К. Знак "элементарного" магнитокалорического эффекта определяется знаком производной  $(\partial M / \partial T)_H$ . Для изотермических кривых намагничивания со скачками эта производная положительна при приближении к полю кроссовера (при нагревании скачки размыкаются), что и объясняет охлаждение кристалла вблизи кроссовера.

Исследования эффекта пересечения энергетических уровней дают существенную информацию о спектре и волновых функциях РЗ иона и направлены, в конечном счете, на исследование кристаллического поля. Хорошее совпадение рассчитанных и экспериментальных данных для  $\text{YbPO}_4$  подтверждает, что процесс намагничивания в сверхсильном поле близок к адиабатическому. При этом в зависимости от характера уровней, участвующих в кроссовере, вблизи кроссовера может наблюдаться как нагревание, так и охлаждение образца. Охлаждение кристалла при этом делает в ряде случаев аномалии на магнитных характеристиках даже более ярко выраженными, чем при изотермическом процессе в статических полях. Это позволяет проводить исследование эффектов кроссовера по магнитным измерениям в импульсных сильных и сверхсильных полях. Подчеркнем, что, как показывают наши расчеты, подобных эффектов можно ожидать для целого ряда соединений из группы РЗ оксидов со структурой циркона.

- 
1. B.R.Cooper, Phys. Lett. **22**, 244 (1966).
  2. M.Guillot, A.Marchand, V.Nekvasil, and F.Tcheou, J. Phys. C**18**, 3547 (1985).
  3. J.E.Battison, A.Kasten, M.J.M.Leask, and J.B.Lowry, J. Phys. C**10**, 323 (1977).
  4. T.Goto, A.Tamaki, T.Fujimura, and H.Unoki, J. Phys. Soc. Japan **55**, 1613 (1986).
  5. P.Morin, J.Rouchy, and Z.Kazei, Phys. Rev. B**51**, 15103 (1995).
  6. A.I.Pavlovskii, N.P.Kolokol'chikov, and O.M.Tatsenko, *Megagauss Physics and Techniques*, Ed. P.Turchi, N.Y.: Plenum Press, 1980.
  7. Landolt-Bornstein, *Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology*, vol.27/e, Ed. H.P.J.Wijn, Springer-Verlag, Berlin, 1991.
  8. P.C.Becker, T.Hayhurst, G.Shalimoff et al., J. Chem. Phys. **81**, 2872 (1984).
  9. P.C.Becker, N. Edelstain, G.M.Williams et al., Phys. Rev. B**45**, 5027 (1992).
  10. A.Kasten, H.G.Kahle, P.Klofer, and D.Schafer-Siebert, Phys. Stat. Sol. (b) **144**, 423 (1987).